

平成29年度

新潟大学理学部第3年次編入学試験

物理学科

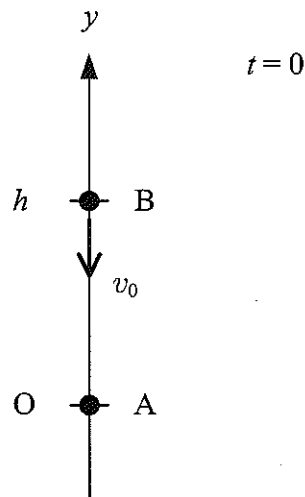
筆記試験問題（物理学）

注意事項

1. 開始の合図があるまでこの冊子を開いてはいけません。
2. 試験開始後、次のものが配布されているか確認してください。
問題冊子1部，解答用紙3枚
3. 問題は全部で3問あります。3問すべて解答してください。
各解答用紙に受験番号を記入してください。
4. 解答時間は120分です。途中で退席することはできません。
5. 試験終了後、問題冊子は各自持ち帰ってください。

I.

図のように、鉛直上向きを正とする y 軸がある。はじめ、質量 m の小球 A が原点 O にあり、また同じ質量の小球 B が原点 O より h だけ上にある。時刻 $t = 0$ に、小球 A は静かに落下し、小球 B は初速 v_0 で落下しはじめ、しばらくすると小球 A と小球 B は衝突した。ここで、 h は正とし、重力加速度の大きさを g とする。



まずは、空気抵抗を無視できるものとして、以下の問いに答えよ。

1. 小球 A と小球 B の運動方程式をそれぞれ書け。
2. 衝突するまでの小球 A と小球 B の速度と位置を時刻 t の関数としてそれぞれ求めよ。
3. 小球 A と小球 B が衝突する時刻を求めよ。

次に、速度に比例する空気抵抗がある場合を考える。小球 A と小球 B の空気抵抗の比例係数を k として、以下の問いに答えよ。ただし、 k は正である。

4. 小球 A と小球 B の運動方程式をそれぞれ書け。
5. 問 4 の運動方程式を解いて、衝突するまでの小球 A と小球 B の速度を時刻 t の関数としてそれぞれ求めよ。

小球 B の初速 v_0 を調整したところ、小球 B が常に一定の速度で落下した。

6. このときの小球 B の初速 v_0 を求めよ。
7. 衝突するまでの小球 A と小球 B の位置を時刻 t の関数としてそれぞれ求めよ。
8. 小球 A と小球 B が衝突する時刻を求めよ。また、小球 A と小球 B が衝突するための h の条件を示せ。

II. 次の1, 2の設問に答えよ。

1. 図1のように、正方形の金属板2枚からなる平行板コンデンサーがある。金属板の一辺の長さは L 、金属板の間隔は d であり、コンデンサーの内部は真空である。また、 L は d に比べて十分に大きく、コンデンサーの端での電場の乱れは無視できるものとする。上側の金属板に電荷 Q を、下側の金属板に電荷 $-Q$ を蓄えた。真空の誘電率を ϵ_0 とし、以下の問いに答えよ。

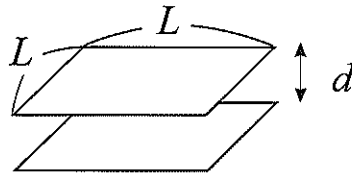


図1

- コンデンサー内の電場の大きさ E を求めよ。
- コンデンサーに蓄えられている静電エネルギーを求めよ。
- コンデンサーに蓄えられている静電エネルギーを電場のエネルギーと解釈する。コンデンサー内の電場の持つ単位体積あたりのエネルギーを、 E と ϵ_0 を用いて表せ。

次に、平行板コンデンサー中に誘電率 ϵ_1 、および ϵ_2 の誘電体を挿入した。このとき、図2に表すコンデンサーの断面のように、2種類の誘電体の境界は金属板と平行になっており、誘電率 ϵ_1 、 ϵ_2 の誘電体の厚さはともに $d/2$ であるとする。

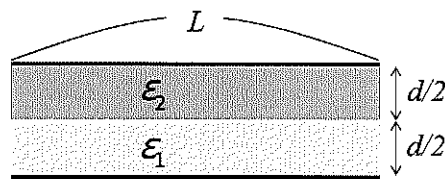


図2

- 誘電率 ϵ_1 、 ϵ_2 の誘電体中の電場の大きさを、それぞれ E_1 、 E_2 とする。誘電体の境界面にガウスの法則を用いて、 $\epsilon_1 E_1 = \epsilon_2 E_2$ の関係が成り立つことを示せ。
- 上下の金属板の電荷は、それぞれ Q 、 $-Q$ のままであるとし、コンデンサーに蓄えられている静電エネルギーを求めよ。

2. 図3のように直交座標があり、その z 軸上に置かれた無限に長い導線に定常電流が流れている。電流の向きは z 軸方向の正の向きで、その大きさは I であるとする。真空の透磁率を μ_0 とし、以下の問いに答えよ。

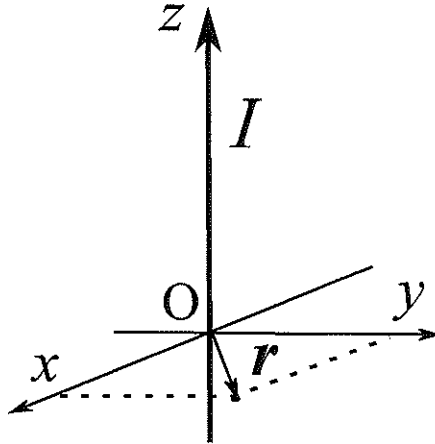


図3

- a. アンペールの法則を用いて、位置 $\mathbf{r} = (x, y, 0)$ での磁束密度の大きさを求めよ。
 b. この電流が位置 $\mathbf{r} = (x, y, 0)$ に作るベクトルポテンシャルは、

$$\mathbf{A} = (0, 0, -k \log r)$$

と表わされることが知られている。ただし、 $r = |\mathbf{r}|$ であり、 k は定数である。このベクトルポテンシャルより、位置 \mathbf{r} での磁束密度 \mathbf{B} を求め、定数 k を μ_0 , I を用いて表わせ。

- c. 問bで求めた磁束密度が、 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ を満たすことを計算で示せ。また、一般に磁束密度 \mathbf{B} に対し、 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ が成り立つ。この式の物理的な意味を簡潔に述べよ。

III. 次の 1, 2 の設問に答えよ。

1. 以下のように行列 A, B, C を定義する。

$$A = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \frac{1}{i\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

また, I を 3×3 の単位行列とする。ここで, i は虚数単位で $i = \sqrt{-1}$ である。

a. $A^2 + B^2 + C^2 = kI$ となることを示し, 定数 k を求めよ。

b. A の固有値を求めよ。

c. 一般に, 正方行列 M の指数関数 e^M は, 無限級数 $e^M \equiv \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} M^n$ で定義される。 α を実定数としたとき,

$$e^{i\alpha C} = \begin{pmatrix} e^{i\alpha} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-i\alpha} \end{pmatrix}$$

となることを示せ。

d. ベクトル $\vec{v}(\phi)$ を $\vec{v}(\phi) = \frac{\sin \phi}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{i \cos \phi}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ と定義する。このとき, $e^{i\alpha C} \vec{v}(\phi) = \vec{v}(\phi')$ と書けることを示し, ϕ' を求めよ。ただし, ϕ と ϕ' は実定数である。

2. 定数係数の2階線形微分方程式

$$\frac{d^2y}{dt^2} - 4\frac{dy}{dt} + 3y = e^{5t} \quad (1)$$

の一般解を求める。

a. 斉次微分方程式

$$\frac{d^2y}{dt^2} - 4\frac{dy}{dt} + 3y = 0$$

の基本解を求めよ。

b. 式(1)の特解を $y(t) = Ce^{\alpha t}$ とおいて, 定数 C と α を求めよ。

c. 式(1)の一般解を求めよ。

次に, 変数係数の2階微分方程式

$$x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 3x \frac{dy}{dx} + 3y = x^5 \quad (2)$$

の一般解を求める。

d. $x = e^t$ とおくことで, 式(2)が式(1)に書き換えられることを示せ。

e. 式(2)の一般解を求めよ。